

Влияние распределения примеси на прямую ВАХ арсенидгаллиевых силовых диодных структур

Velmre, Enn; Freidin, Boris Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 32-37 : ил

https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Исследование процесса переключения диодных структур низковольтных диодов с эпитаксиальной базовой областью

Vaher, G.; Velmre, Enn; Lumi, J.; Tarma, Mati; Udal, Andres Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 13-17 : ил

https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Исследование прямой ВАХ мощных диодов с узкой базовой областью

Vaher, G.; Velmre, Enn; Tarma, Mati Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 9-12 : ил

https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Неоднородность включения разветвленного катода КВТ

Saks, P.; Seilenthal, Mats Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 104-106

https://www.ester.ee/record=b1356516*est

О динамических параметрах разрабатываемых комбинированно-выключаемых тиристорov

Saks, P.; Tarma, Mati Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 107-110 https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Численное моделирование процесса выключения одномерных кремниевых тиристорных структур

Velmre, Enn; Udal, Andres Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 74-79 : ил

https://www.ester.ee/record=b1356516*est

Численное моделирование физических процессов в прямосмещенных структурах на основе прямозонных полупроводников

Velmre, Enn; Freidin, Boris Полупроводниковые приборы : сборник статей 1982 / с. 25-31 : ил

https://www.ester.ee/record=b1356516*est